**応用物理学会学術講演会予稿のタイトル**

**Title of Extended Abstract of the Japan Society of Applied Physics**

**東大物性研1，応物中研2　○(M2)小松原 望1，(M1)応物 花子2**

***ISSP Univ. of Tokyo* 1, Oubutsu Central Research Lab. 2,** ○**Nozomu Komatsubara1, Hanako Oubutsu2**

**E-mail: nozomu.km@issp.u-tokyo.ac.jp**

半導体利得スイッチングレーザーから直接短パルスを出力させることは応用を考える上で非常に重要なことである。先の研究で数ピコ秒程度の短パルス光を発生させるためには、半導体の利得を大きくすること、つまり量子井戸の活性層を厚くすることが有利であるという報告がされている[1]。そこで今回歪補償InGaAs/GaAs材料を用いた10周期多重量子井戸半導体レーザーを作製しその基本的な特製評価を行なった。



[1] S.Chen et al,Opt.Express **25**, 13046 (2017)